

特定領域研究「窒化物光半導体のフロンティア —材料潜在能力の極限発現—」
平成 20 年度研究成果報告会プログラム

日時:平成 21 年 3 月 11 日(水)~12 日(木)

場所:鳥羽シーサイドホテル(三重県鳥羽市)

1 日目:2009 年 3 月 11 日(水)

13:30~13:40 挨拶

領域代表 名西 惲之 (立命館大)

A02-1 13:40~14:05

極広域分光による InN 薄膜のキャリア移動度・輻射強度評価

○石谷 善博, 吉川 明彦 (千葉大)

A02-2 14:05~14:30

高 Al 組成 AlGaIn の輻射・非輻射再結合過程の解明と制御

○川上 養一, 船戸 充 (京都大)

A02-3 14:30~14:55

III 族窒化物半導体の点欠陥の諸特性 — 空孔集合体, 空孔酸素複合体及びその磁気特性 —

○上殿 明良¹, 秩父 重英², 白石 賢二¹, 押山 淳³ (1 筑波大, 2 東北大, 3 東京大)

A02-4 14:55~15:20

GaN の欠陥準位評価と制御プロセス

○橋詰 保, 佐藤 威友 (北海道大)

15:20~16:00 コーヒーブレイク

A02-5 16:00~16:25

窒化物半導体の非線形光学定数の精密評価と内部電界による制御

○近藤 高志¹, 阿部 真¹, 須田 淳², 庄司 一郎³ (1 東京大, 2 京都大, 3 中央大)

A02-6 16:25~16:50

窒化アルミニウム系深紫外半導体における高密度励起子系の光物性評価と光機能性

— 高品質窒化アルミニウム薄膜の励起子系光学特性 —

山田 陽一 (山口大)

A02-7 16:50~17:15

窒化物半導体結晶のナノレベル構造評価解析技術の革新 — III

桑野 範之 (九州大)

17:15~17:30 A02 の発表に対する総合討論 (司会: 吉川先生)

18:30~20:30 夕食・懇親会

2 日目:2009 年 3 月 12 日(木)

A03-1 08:30~08:55

ワットクラス超高出力紫外レーザダイオードの実現に向けて

○天野 浩, 岩谷素顕, 上山 智, 赤崎 勇 (名城大)

A03-2 08:55~09:20

高品質 AlGaIn 結晶の成長と紫外・深紫外発光デバイス

— 交互供給 MOVPE 法による AlGaIn 層の高品質化 —

川西 英雄 (工学院大)

A03-3 09:20~09:45

220-260nm 帯 AlGaIn 系紫外 LED の高効率化

平山 秀樹 (理研)

09:45~10:00 A03 の発表に対する総合討論 (司会: 天野先生)

10:00~10:25 コーヒーブレイク

A04-1 10:25~10:50

赤色～赤外域 AlGaInN 系光デバイス基盤技術の開拓－III

○岸野 克巳, 菊池昭彦, 野村一郎 (上智大)

A04-2 10:50~11:15

InAlN 系タンデム太陽電池の研究: MOVPE 法による In-rich InAlN の成長と評価

山本 嵩勇, 橋本 明弘, ○福井 一俊 (福井大)

A04-3 11:15~11:40

再現性に優れた GaInNAs 結晶技術の確立および長波長半導体レーザへの適用

○近藤 正彦, 森藤 正人, 百瀬 英毅, 石川 史太郎 (大阪大)

A04-4 11:40~12:05

InN をベースとした長波長円偏光半導体レーザ創製に関する研究

○朝日 一, 長谷川 繁彦, 江村 修一, 周 逸凱 (大阪大)

12:05~12:20 A04 の発表に対する総合討論 (司会: 岸野先生)

12:20~13:30 昼食

A01-1 13:30~13:55

RF-MBE 法による InN および関連混晶の成長と量子ナノ構造の形成

○名西 惲之, 荒木 努, 山口 智広, 金子 昌充, 王 科 (立命館大)

A01-2 13:55~14:20

パルス励起堆積法による窒化インジウム系半導体の低温成長

○藤岡 洋, 太田 実雄 (東京大)

A01-3 14:20~14:45

AlN サファイア上 AlGaIn 成長のその場観察と組成制御

○三宅 秀人, 平松 和政 (三重大)

A01-4 14:45~15:10

原料分子制御法による InN 厚膜エピタキシャル成長 — 成長初期層の検討 —

○村上 尚, 熊谷義直, 瀬瀬明伯 (東京農工大)

15:10~15:35 コーヒーブレイク

A01-5 15:35~16:00

有機 N 原料による InN 薄膜の MOVPE 成長 II

ティユ クァン トウ, 中川 隆, 関 裕紀, 窪谷 茂幸, 片山 竜二, ○尾鍋 研太郎 (東京大)

A01-6 16:00~16:25

Si 基板上半極性面への InGaIn 結晶成長

○本田 善央, 澤木 宣彦 (名古屋大)

16:25~16:40 A01 の発表に対する総合討論 (司会: 名西先生)

16:40~16:50 評価担当の先生方からの総評

19:30~21:00 総括班打合せ